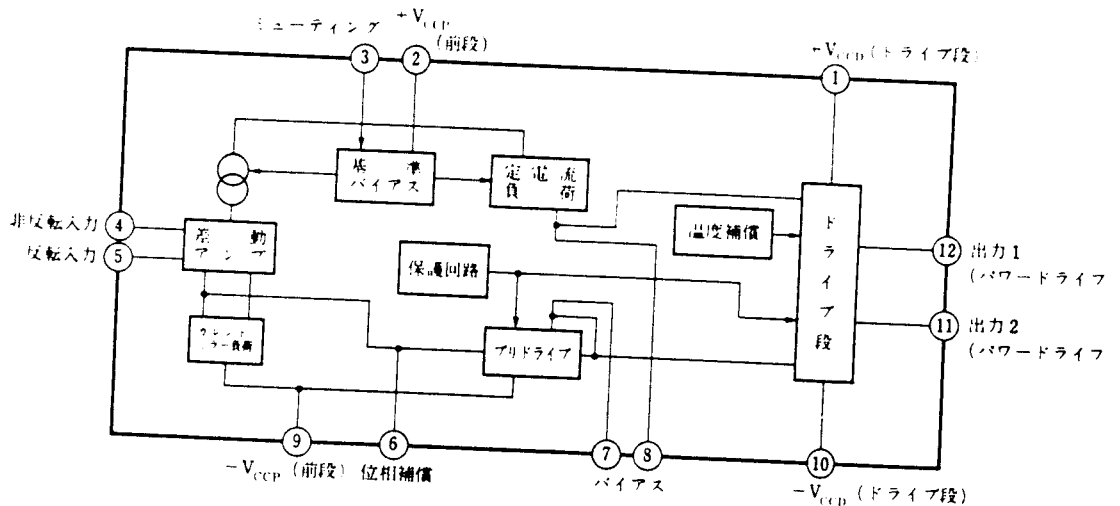


30~50 Wパワーアンプドライバ回路

μ PC1270Hは、ステレオハイファイパワーアンプ用ドライバICとして開発された半導体集積回路です。内部回路は、電圧増幅回路、プリドライ回路、ドライブ回路、保護回路により構成されています。外形は、12 Pin小形シングルインラインパッケージです。

特長/Features

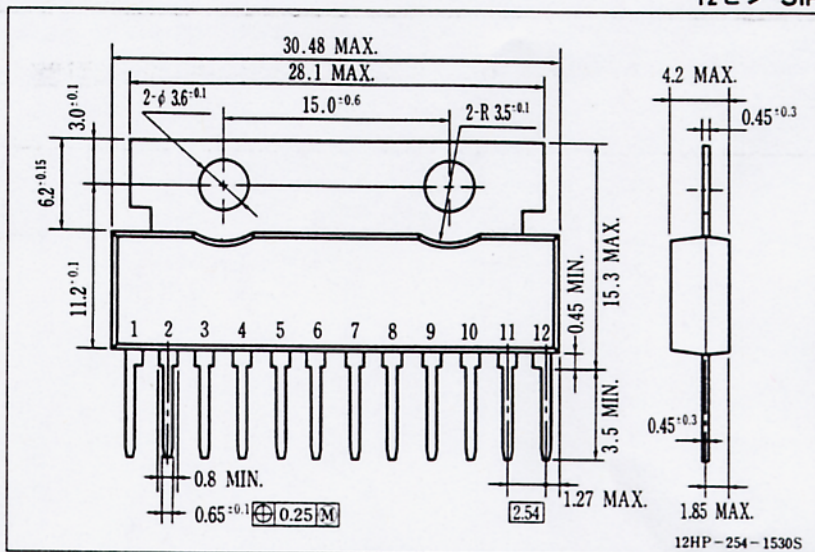
- 低ひずみ率です。
0.002 % TYP. ($V_{CC} = \pm 36$ V, $f = 1$ kHz, $A_v = 30$ dB, $P_o = 30$ W, $R_L = 8 \Omega$)
0.006 % TYP. ($V_{CC} = \pm 36$ V, $f = 20$ kHz, $A_v = 30$ dB, $P_o = 30$ W, $R_L = 8 \Omega$)
- 周波数特性が良い。
900 kHz TYP. (-3 dB)
- パワー・バンド幅が広い。
90 kHz TYP. ($P_o = 25$ W, T.H.D. = 0.1 %)
- 電源ON/OFF時ポップノイズが極めて小さい。



注) 保護回路は、ICを保護する為のものであり、 P_o , T_R の保護については、別に考慮、設計してください。

外形図/Package Dimensions (Unit: mm)

12ピン SIP



端子接続

端子No.	接 続
1	+V _{CCD} (ドライブ段電源)
2	+V _{CCP} (プリドライブ段電源)
3	MUTING
4	INPUT
5	NFB
6	PHASE COMP
7	BIAS
8	BIAS
9	-V _{CCP} (プリドライブ段電源)
10	-V _{CCD} (ドライブ段電源)
11	LOWER OUTPUT
12	UPPER OUTPUT

絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

項目	略号	定格	単位
無信号時電源電圧	V_{CC1}	± 50	V
信号時電源電圧	V_{CC2}	± 45	V
回路電流	$I_{CC(peak)}$	200	mA
パッケージ許容損失	P_D	4.1 *	W
動作温度	T_{opt}	$-20\sim+75$	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-40\sim+150$	$^\circ\text{C}$

* $T_a=75\text{ }^\circ\text{C}$
 100 mm×100 mm×1 mm
 アルミ放熱板使用

推奨動作範囲/Recommended Operating Conditions

項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位	備考
信号時電源電圧	V_{CC3}	± 18		± 36	V	定格出力時
入力バイアス抵抗	R_{IN}	1	50	100	k Ω	
パワートランジスタ h_{FE}	h_{FE}	50				最大出力時の h_{FE}
閉ループ電圧利得	A_V	26	30		dB	

電気的特性/Electrical Characteristics ($V_{CC}=\pm 36\text{ V}$, $A_V=30\text{ dB}$, 標準測定回路による, $T_a=25\text{ }^\circ\text{C}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
出力オフセット電圧	V_{OFF}	測定回路1.による		± 5	± 100	mV
無信号時回路電流	I_{CC}	$V_{IN}=0$		20	40	mA
最大出力電圧	V_{OM}	T.H.D.=0.05%, $f=20\text{ Hz}\sim 20\text{ kHz}$	20	23		V
開ループ電圧利得	A_{VO}	$V_O=1.5\text{ V}$, $f=1\text{ kHz}$	80	95		dB
出力雑音電圧	V_{NO}	$R_G=10\text{ k}\Omega$		0.07	0.14	mV
周波数特性	P.B.W.	$V_O=1.5\text{ V}$, -3 dB		900		kHz
ハム抑圧比	S.V.R.	$R_G=2\text{ k}\Omega$, $f=100\text{ Hz}$	55	70		dB
ミュートON時出力オフセット電圧	$V_{OFF(MUTE)}$	$V_{CC}=\pm 50\text{ V}$, 測定回路7.による			± 50	mV